

深圳市晶盟电子科技有限公司

产品说明书

SPECIFICATIONS

型号: JM-A1308D-GR

公司: 深圳市晶盟电子科技有限公司

地址: 广东省深圳市宝安区西乡三围社区索佳科技园索佳综合楼A902

电话: 0755-23200023

传真: 0755-29593377

网址: www.uniled.com.cn

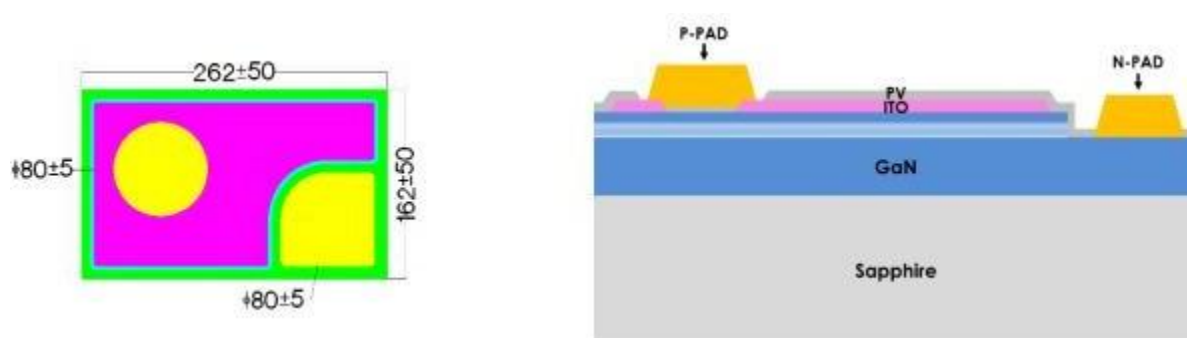
一、产品特点

- ◆ 高辐射通量
- ◆ 长使用寿命

二、产品应用

- ◆ 一般照明

三、LED芯片图示



四、产品尺寸

- ◆ 芯片尺寸/Chip size: $162 \pm 50 \mu\text{m} \times 262 \pm 50 \mu\text{m}$
- ◆ 芯片厚度/Chip thickness: $120 \pm 25 \mu\text{m}$
- ◆ P焊盘直径/P bonding pad diameter: $80 \pm 5 \mu\text{m}$
- ◆ N焊盘直径/N bonding pad diameter: $80 \pm 5 \mu\text{m}$

五、电极金属

- ◆ P电极/P electrode: Au alloy
- ◆ N电极/N electrode: Au alloy

六、光电参数

(Ta=25℃)

参数 Parameter	测试条件 Testing condition	符号 Symbol	最小值 Min.	最大值 Max.	单位 Unit
正向电压 Forward Voltage	If=1uA	Vf	1.8	3.0	V
正向电压 Forward Voltage	If=10mA	S	2.4	2.5	V
		L	2.5	2.6	
		M	2.6	2.7	
		N	2.7	2.8	
		O	2.8	2.9	
		P	2.9	3.0	
		Q	3.0	3.1	
		R	3.1	3.2	
波长 Wavelength (WLD)	If=10mA	W3	517.5	519.0	nm
		W4	519.0	520.5	
		W5	520.5	522.0	
		W6	522.0	523.5	
		W7	523.5	525.0	
		W8	525.0	526.5	
		W9	526.5	528.0	
		WZ	528.0	529.5	
		WA	529.5	531.0	
		WB	531.0	532.5	
光功率 Light Output Power	If=10mA	DA	4.0	5.0	mW
		DB	5.0	6.0	
		DC	6.0	7.0	
		DD	7.0	8.0	

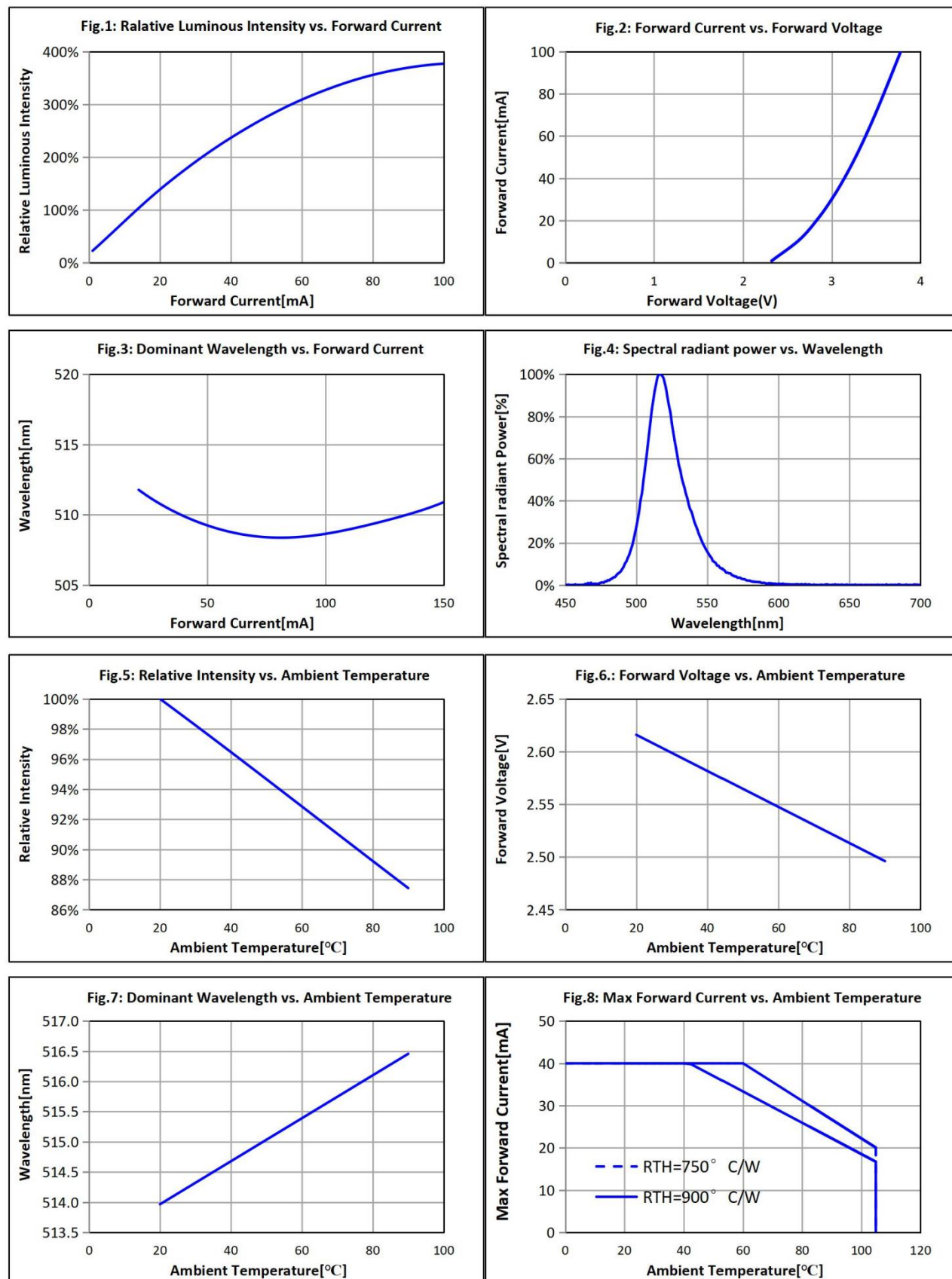
※ 光电参数测量以工厂标准机测量为准。

※ 亮度公差容许范围Tolerance limit of Po: ±6%

※ 波长公差容许范围Tolerance limit of Wd: ±1nm

※ 正向电压公差容许范围Tolerance limit of VF : ± 0.06V

七、特征曲线



八、最大额定值

Parameter	Symbol	Condition	Rating	Unit
正向直流电流 Forward DC Current	I_f	$T_a=25^{\circ}\text{C}$	≤ 40	mA
反向电压 Reverse Voltage	V_z	$T_a=25^{\circ}\text{C}$	≥ 10	V
反向电流 Reverse Current	I_r	$T_a=25^{\circ}\text{C}$	≤ 1	uA
结温 Junction Temperature	T_j	---	≤ 150	$^{\circ}\text{C}$
封装温度 Temperature During Packaging	---	---	280 (<10s)	$^{\circ}\text{C}$
储存温度 Storage Temperature	---	Chip on tape/storage	0~40	$^{\circ}\text{C}$
静电测试 ESD	---	通过率 95%	3000	V

九、包装规格

- ◆ 标准蓝膜尺寸 (200±10) mm × (200±10) mm
- ◆ 芯片粘贴区域
- ◆ 标签贴于蓝膜右下角，标签内容包括：公司名称、型号、数量、光电参数

